

The Data Book Project

DatasheetArchive.com has launched an ambitious effort to digitize thousands of obsolete data books and technical manuals, making them searchable via the DatasheetArchive website.

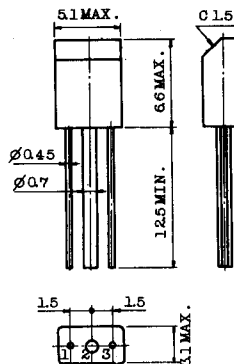
Scroll down to see the scanned document.

シリコンNPN三重拡散形トランジスタ(PCT方式)
SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED TRANSISTOR (PCT PROCESS)

2SC983

- 白黒テレビ映像出力用
- 高耐圧スイッチング用
- Black and White TV Video Output and High Voltage Switching Applications
- ・ 高耐圧です; $V_{CE0}=150V$
- ・ コレクタ出力容量が小さい; $C_{ob}=5.5pF$ (Max.)
- ・ トランジション周波数が高い; $f_T=120MHz$ (Typ.)

Unit in mm



1. EMITTER
2. COLLECTOR
3. BASE

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ C$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	250	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	150	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	50	mA
エミッタ電流	I_E	-50	mA
コレクタ損失	P_C	600	mW
接合温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55~150	$^\circ C$

JEDEC	-
EIAJ	-
TOSHIBA	2-5E1A

ラジエータ・ホルダ RH-16 を適用
RADIATOR HOLDER RH-16

※ PCT 技術により製造されています。

Produced by Perfect Crystal Device Technology.

2SC983

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25°C)

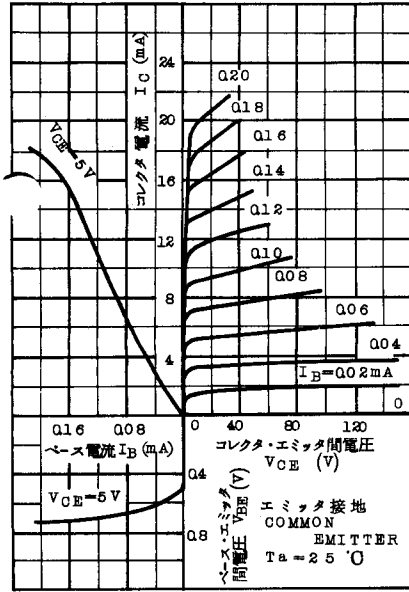
CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=30V, I_E=0$	—	—	0.1	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=5V, I_C=0$	—	—	1.0	μA
直流電流増幅率 (Note)	h_{FE}	$V_{CE}=5V, I_C=10mA$	40	—	240	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=10mA, I_B=1mA$	—	—	0.5	V
ベース・エミッタ間飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=10mA, I_B=1mA$	—	—	1.2	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=30V, I_E=-10mA$	40	120	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz$	—	—	5.5	pF
ベース拡がり抵抗	r_{bb}	$V_{CE}=6V, I_E=-1mA$ $f=30MHz$	—	25	60	Ω

Note : h_{FE} により下表のように分類し、現品表示してあります。

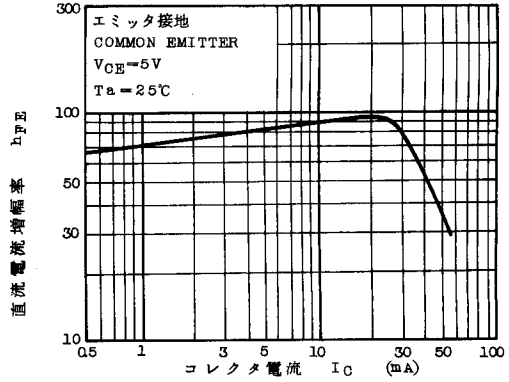
According to the value of h_{FE} , the 2SC983 is classified as follows.

CLASSIFICATION	MIN.	MAX.
2SC983-R	40	80
2SC983-O	70	140
2SC983-Y	120	240

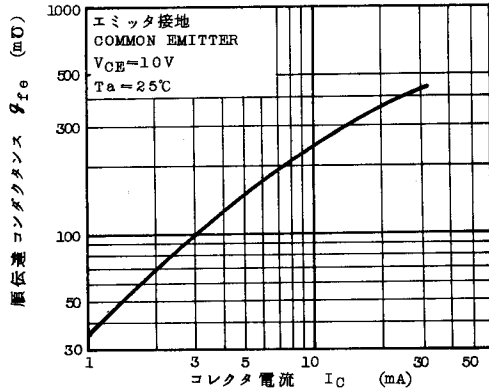
STATIC CHARACTERISTICS



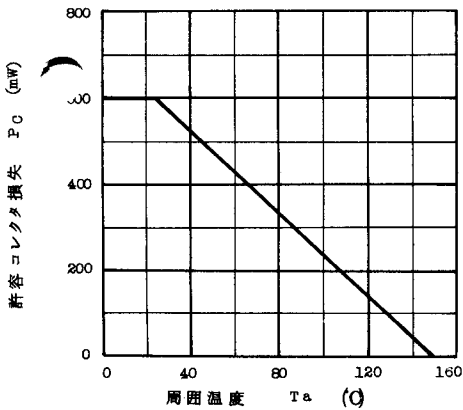
$h_{FE} - I_C$



$\beta_{fe} - I_C$



$P_C - T_a$



$f_T - I_E$

